

電気通信大学 平成18年度シラバス

授業科目名	半導体工学		
英文授業科目名	Semiconductor Engineering		
開講年度	2006年度	開講年次	3年次
開講学期	5学期	開講コース・課程	夜間主コース
授業の方法		単位数	2
科目区分	専門科目-学科専門科目-選択科目		
開講学科・専攻	電子工学科 量子・物質工学科		
担当教官名	一色 秀夫		
居室	西2-517		

公開E-Mail	授業関連Webページ
hisshiki@ee.uec.ac.jp	

<p><b>【主題および達成目標】</b></p> <p>(a) 主題：IT革命の原動力である半導体デバイスについて、その成り立ちから半導体集積回路の基本要素であるMOSトランジスタの動作原理まで解説する。あらゆる半導体デバイスの基本原理となる半導体界面・接合の物理現象を理解し、それらをどのようにデバイスに利用しているかを学ぶ。</p> <p>(b) 達成目標：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半導体界面・接合の物理現象の理解</li> <li>・半導体デバイスの動作原理の理解</li> </ul> <p>(c) 学習・教育目標との対応</p> <p>科学的思考能力：60%、専門知識とその応用力：20%、継続学習能力：20%</p>
--

<p><b>【前もって履修しておくべき科目】</b></p> <p>基礎電子工学</p>
--

<p><b>【前もって履修しておくことが望ましい科目】</b></p> <p>なし</p>
---

<p><b>【教科書等】</b></p> <p>教科書：濱川圭弘編著：半導体デバイス工学、オーム社（2000） 参考書：高橋清 著：半導体工学(第2版)、森北出版（1993）</p>
---

## 電気通信大学 平成18年度シラバス

### 【授業内容とその進め方】

以下の内容について1~3週で講義を行なう。

- 1) 半導体デバイス開発の歴史
- 2) 半導体の電子物性(基礎電子工学の復習)
- 3) 半導体の界面と接合
- 4) ダイオード
- 5) バイポーラ・トランジスター
- 6) MOSトランジスター

### 【成績評価方法及び評価基準(最低達成基準を含む)】

(a) 評価方法: レポート、中間試験および期末試験の結果を次の比重で総合評価する。

レポート: 40%、中間試験: 30%、期末試験: 30%

(b) 評価基準: 最低基準はレポート、中間試験および期末試験の総計で満点の60%の評価点を得ることとする。

### 【オフィスアワー: 授業相談】

特に設けない。質問等は電子メールで受け付ける。

### 【学生へのメッセージ】

半導体は何故電子工学の分野で広く利用されているのか。  
IT革命において半導体は何故ここまで活躍しているのか。  
その真理を掴んでもらいたい。

### 【その他】